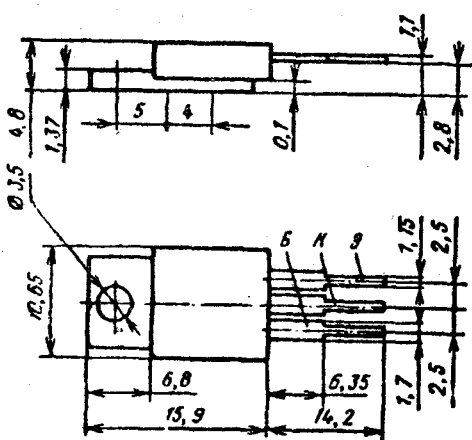


КТ859А



Транзистор кремниевый меза-планарный структуры *n-p-n* переключаемый. Предназначен для применения в переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.
 Масса транзистора не более 3 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 1$ А, не менее	10
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 0,2$ А, $f = 3$ МГц, не менее	3,3*
Граничное напряжение при $I_K = 0,1$ А, $L = 25$ мГн, не менее	400 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А, не более	1,5 В
Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А, не более	1,4 В
Время включения при $U_{КЭ} = 250$ В, $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А, $I_{B,зан} = 0,4$ А, $U_{ВЭ} = -8$ В, не более	0,5* мкс
типичное значение	0,35* мкс
Время рассасывания при $U_{КЭ} = 250$ В, $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А, $I_{B,зан} = 0,4$ А, $U_{ВЭ} = -8$ В	1*...2,5*...3,5* мкс
Время спада при $U_{КЭ} = 250$ В, $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А, $I_{B,зан} = 0,4$ А, $U_{ВЭ} = -8$ В, типичное значение	0,35 мкс
Обратный ток коллектора при $U_{КЭ} = 800$ В, не более	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ВЭ} = 10$ В, не более	10 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер ¹ при $R_{об} \leq 10$ Ом, $T_n = +100$ °С	800 В
Пробивное напряжение коллектор — база ¹ при $T_n = 100$ °С	800 В
Постоянное напряжение база — эмиттер	10 В
Постоянный ток коллектора	3 А
Импульсный ток коллектора	4 А
Постоянный ток базы	1 А
Импульсный ток базы	1,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ² при $T_n = -55...+50$ °С	40 Вт

¹ При $T_n = +100...+150$ °С напряжение снижается линейно до 300 В.
² При $T_n > +50$ °С $P_{К, макс}$ рассчитывается по формуле

$$P_{К, макс} \text{ Вт} = (150 - T_n) / R_{T(n-k)}$$

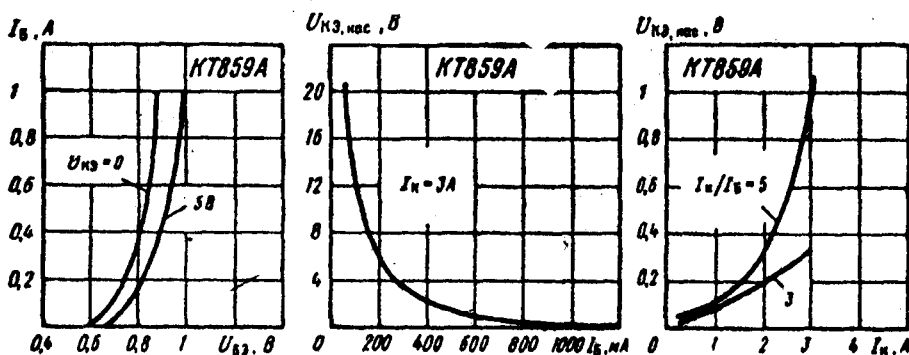
где $R_{T(n-k)}$ определяется из области максимальных режимов.

Температура <i>p-n</i> перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-55 °С... T_n = +100 °С

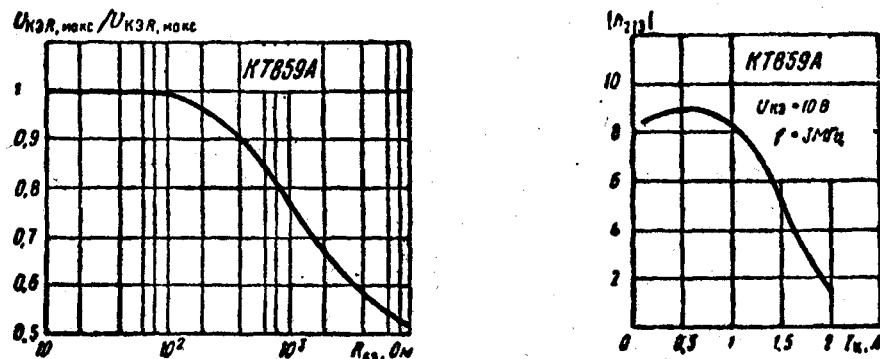
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре корпуса не более +100 °С. При отсутствии контроля температуры корпуса транзистора пайка осуществляется паяльником с температурой не более +280 °С в течение не более 2,5 с. Допускается пайка волной припоя. Минимальная температура пайки +235 °С.

При монтаже транзистора должны быть приняты меры, исключающие возникновение паразитной генерации.

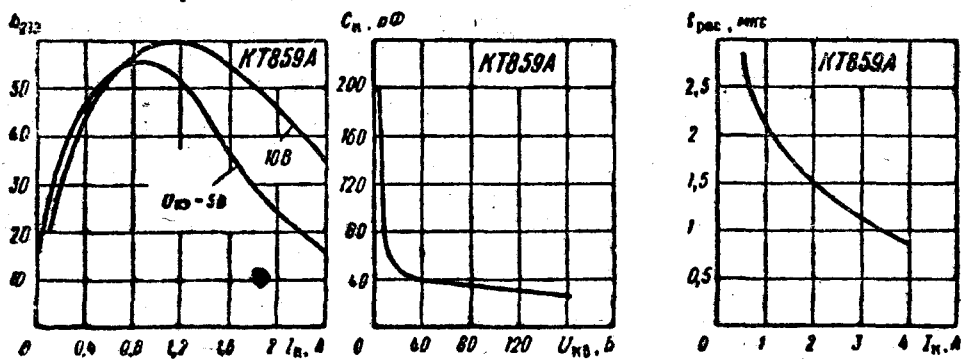
Допустимое значение статического потенциала 2000 В.



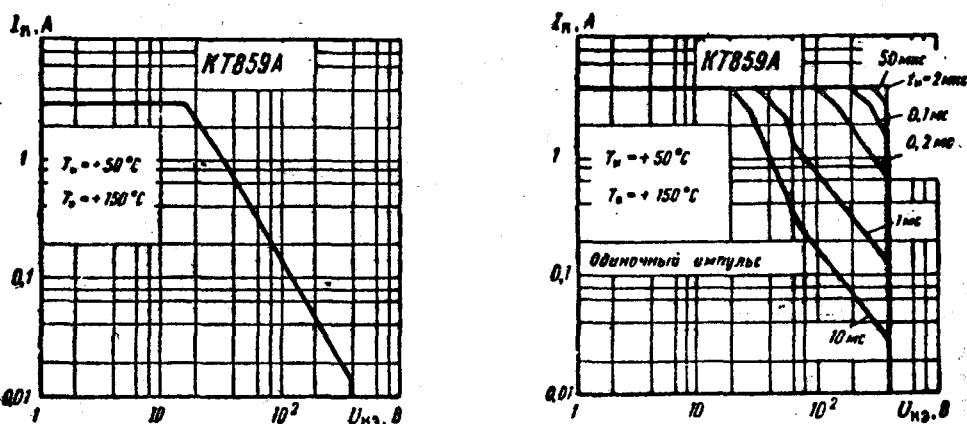
Входные характеристики Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока базы
 Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



Зависимость максимально допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер
 Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора
 Зависимость емкости переходного коллектор — база от напряжения коллектор — база
 Зависимость времени рассасывания от тока коллектора



Область максимальных режимов

Области максимальных режимов